T-43-90

FMC2

エピタキシャルプレーナ形デュアルミニモールド PNP/NPN シリコントランジスタ
スイッチ回路/Switching Circuit
Epitaxial Planar Dual Mini-Mold PNP/NPN Silicon Transistor

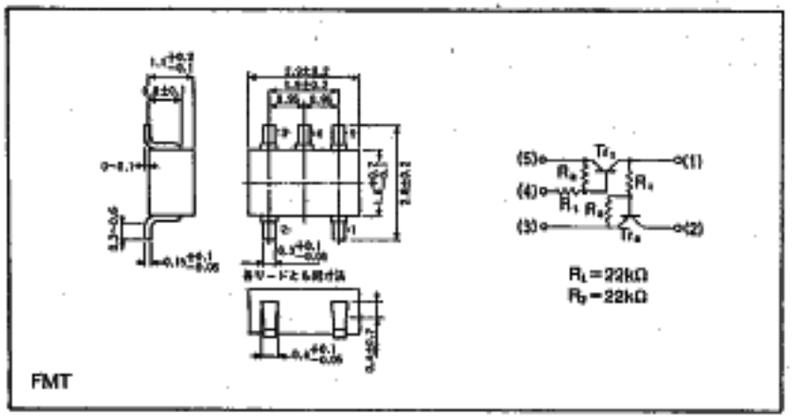
● 特長

1) スーパーミニモールドパッケージで2個のトランジスタを内蔵している。
2) スイッチ回路として最適。

● Feature

1) A super-minimold package houses 2 transistors.
2) Ideal for use in switching circuit.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits		Unit
		Tr_1 (NPN)	Tr_2 (PNP)	
電源電圧	V_{CC}	50	−50	V
入力電圧	V_{IN}	40	10	V
		−10	−40	V
出力電流	I_O	100	−100	mA
	I_O	30	30	mA
許容損失	P_d	300 (TOTAL)*		mW
保存温度範囲	Tstg	−55~125		℃

* ただし，1素子当り200mWをこえないこと。
However, 200mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	$V_{I(OFF)}$	−	−	0.5	V	V_{CC}=5V, I_O=100μA
	$V_{I(ON)}$	3.0	−	−	V	V_O=0.2V, I_O=5mA
出力電圧	$V_{O(ON)}$	−	0.1	0.3	V	I_O=10mA, I_I=0.5mA
入力電流	I_I	−	−	0.36	mA	V_I=5V
出力電流	$I_{O(OFF)}$	−	−	10	μA	V_{CC}=30V, V_I=0V
直流電流増幅率	G_I	56	−	−	−	I_O=5mA, V_O=5V
入力抵抗	R_1	−	22	−	kΩ	−
抵抗比率	R_2/R_1	0.8	1.0	1.2	−	−

注(1)：各特性は個々のデジタルトランジスタ(DTr_1, DTr_2)に対する規格です。
注(2)：Tr_2　PNPトランジスタの一符号は省略しております。

Note(1) Each characteristic relates to the standard for individual digital transistors (DTr_1, DTr_2).
(2) A minus sign for Tr_2 PNP transistor is ommited.

T-43-90

● 標準品・準標準品一覧表

(○：準標準品)

	包装名	テーピング	
	記　号	T148	T149
Type	基本発注単位（個）	3 000	3 000
FMC2		○	○

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

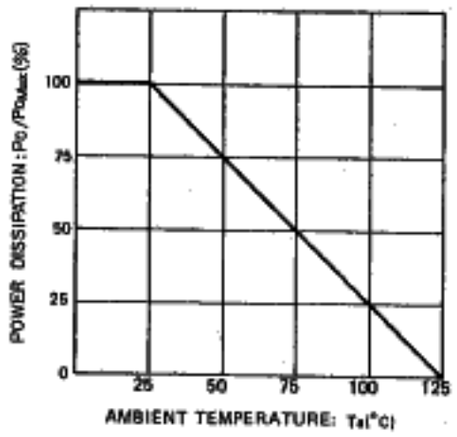


Fig.1　電力軽減曲線

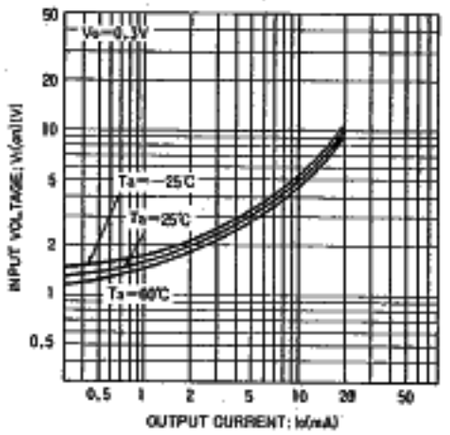


Fig.2　入力電圧—出力電流（ON特性）

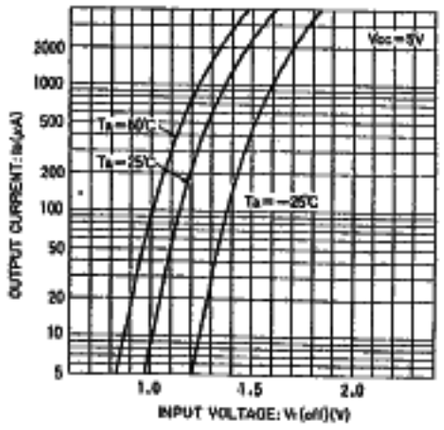


Fig.3　出力電流—入力電圧（OFF特性）

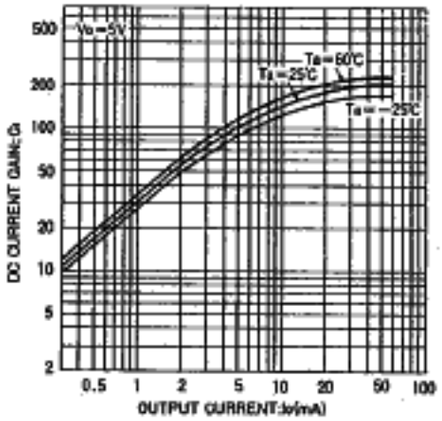


Fig.4　直流電流増幅率—出力電流特性